

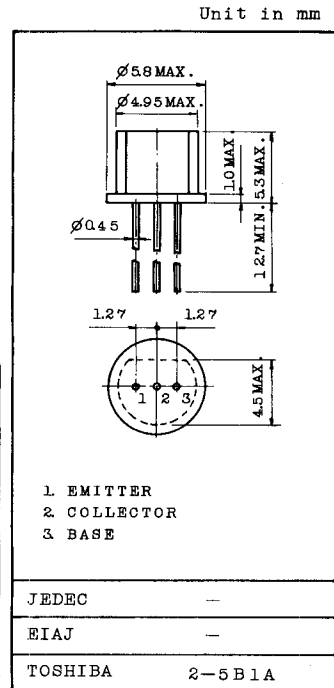
シリコンNPNエピタキシャルプレーナ形トランジスタ
SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR TRANSISTOR

2SC387A

- テレビ UHF チューナ発振用
- TV UHF Oscillator Applications
- ・ トランジション周波数が高い; $f_T=1200\text{MHz}$ (Typ.)
- ・ 930MHz で十分な発振出力が得られます;
 $P_O=8\text{mW}$ (Typ.)($f=930\text{MHz}$)

最大定格 MAXIMUM RATINGS (Ta=25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
コレクタ・ベース間電圧	V _{CBO}	30	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CEO}	15	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EBO}	3	V
コレクタ電流	I _C	50	mA
エミッタ電流	I _E	-50	mA
コレクタ損失	P _C	200	mW
接合温度	T _j	125	°C
保存温度	T _{stg}	-55~125	°C

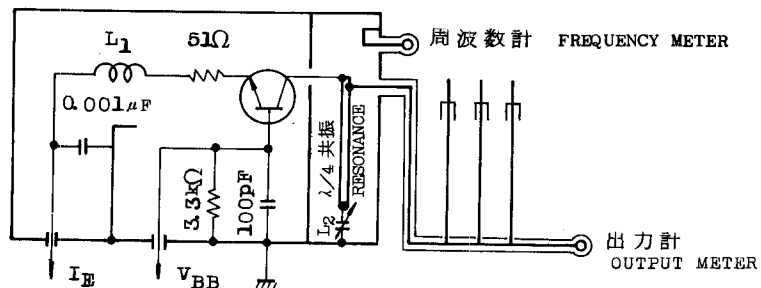


2SC387A

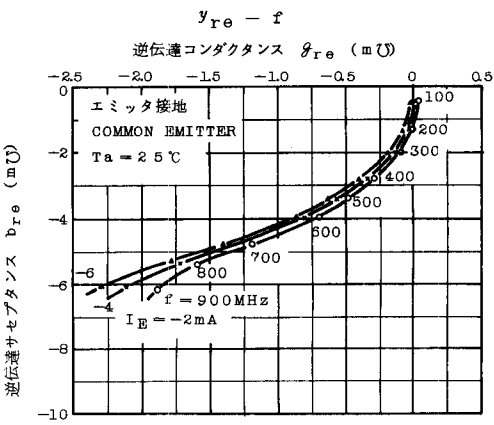
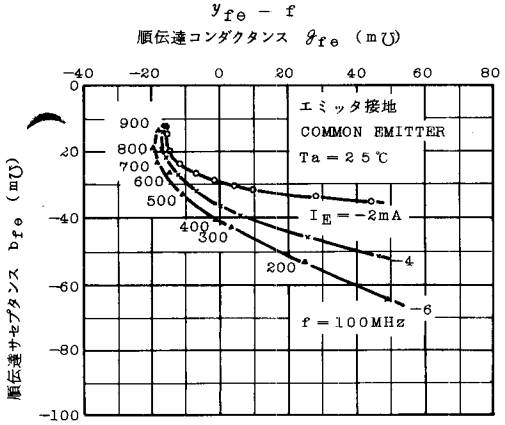
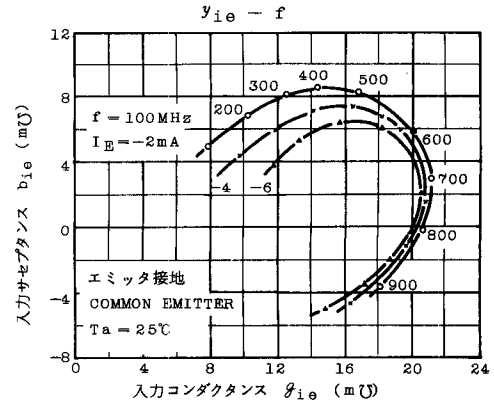
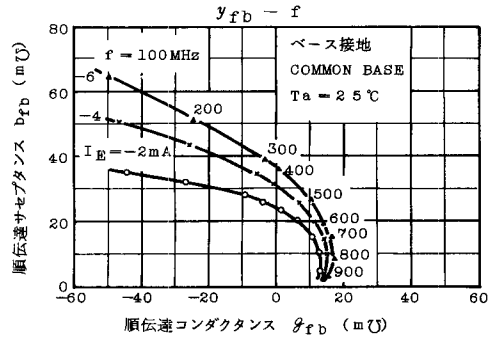
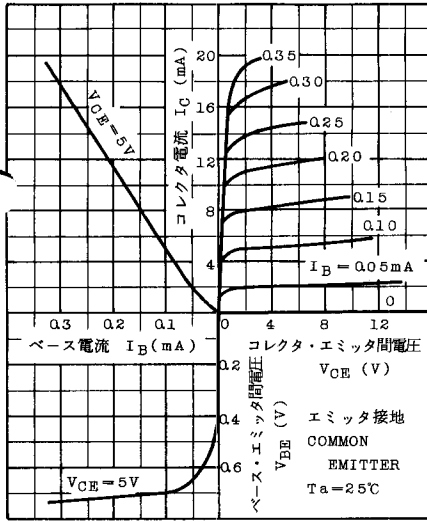
電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
コレクタしや断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 15V$ $I_E = 0$	-	-	0.5	μA
エミッタしや断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 3V$ $I_C = 0$	-	-	10	μA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 1mA$ $I_B = 0$	15	-	-	V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 3V$ $I_C = 8.0mA$	20	-	-	
トランジション周波数	f_T	$V_{CE} = 10V$ $I_E = -8mA$	650	1200	-	MHz
ベース拡がり抵抗	$r_{bb'}$	$V_{CE} = 6V$ $I_E = -2mA$ $f = 30MHz$	-	-	25	Ω
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10V$ $I_E = 0$ $f = 1MHz$	-	-	1.5	pF
出力電力 (Fig. 1)	P_o	$V_{CB} = 10V$ $I_E = -10mA$ $f = 930MHz$	-	8.0	-	mW

Fig. 1 出力電力測定回路 OSC POWER OUTPUT TEST CIRCUIT



STATIC CHARACTERISTICS



2SC387A

